



2018年12月期第3四半期 決算説明資料

株式会社RS Technologies

2018/11/13

代表取締役社長 方 永義



東証1部
3445

目次

会社概要 P.3

会社概要

沿革

現在のRS Technologies

代表取締役方永義の強み

2018年第3四半期決算概要 P.8

2018年12月期第3四半期決算概要

財務諸表

期末配当政策

中国プライムウェーハ事業の現状 P.14

山東省徳州市と提携

中国における当社合併相手について

出資スキーム

Appendix P.18

再生ウェーハビジネス（1）

再生ウェーハビジネス（2）

プライムウェーハビジネスに進出

中国の半導体政策

RS Technologiesの目指す世界

会社概要

- 半導体再生ウェーハで市場シェア3割のトップ企業。中国でのプライムウェーハ事業への参入により、再生ウェーハ専業からプライムウェーハメーカーへ業容拡大

社名	株式会社RS Technologies
設立	2010年12月10日
経営理念	「地球環境を大切にし、世界の人々に信頼され、常に創造し挑戦する。」
事業内容	電子材料、電子機器部品、通信機器部品材料の製造、加工、再生、販売。太陽光発電事業。中古半導体設備の買取及び販売事業。半導体材料・パーツの販売。半導体シリコンウェーハ製造の技術コンサルティング。
本社所在地	東京都品川区大井1-47-1 NTビル 12F
三本木工場	宮城県大崎市三本木音無字山崎26-2
資本金	5,269百万円（2018年9月末時点）
代表取締役	方 永義
連結子会社	艾爾斯半導体股份有限公司（台湾）2014年2月設立 資本金 NT \$300 million
	北京有研RS半導体科技有限公司（北京）登録資本 US \$138 million 出資比率 34.84%
	株式会社ユニオンエレクトロニクス 資本金 20百万円 出資比率 100%

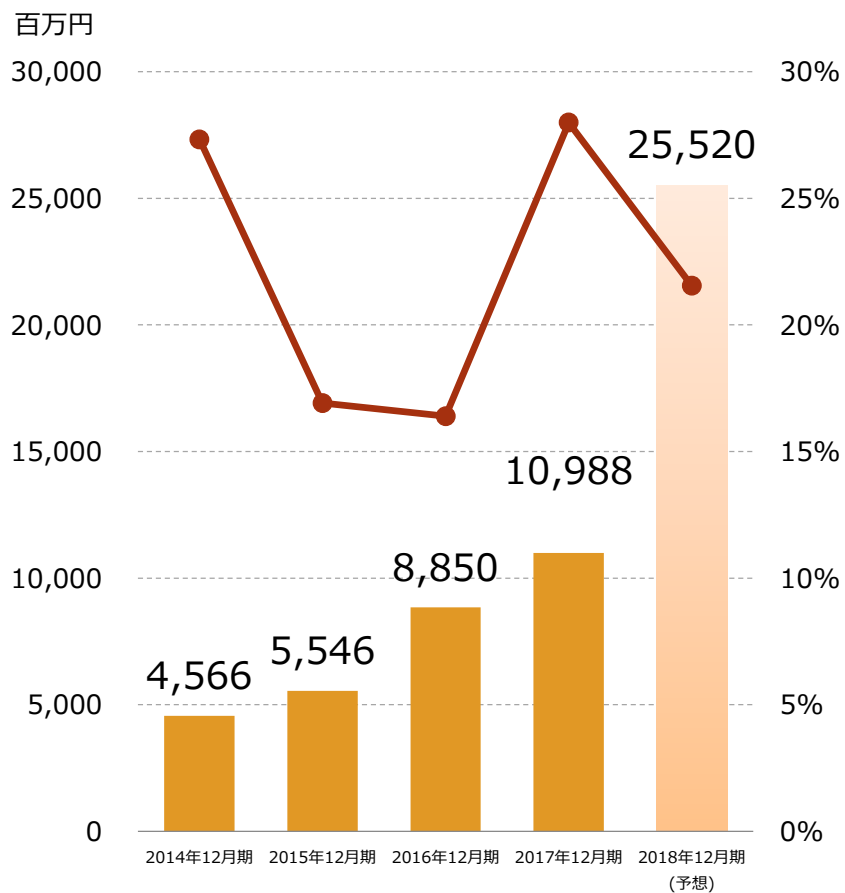
- 2010年に設立。再生ウェーハ事業で世界トップ。2015年に東証マザーズに上場、2016年に東証一部に。2018年中国の大手プライムウェーハメーカーを連結子会社化へ

2010年（平成22年）12月	東京都品川区において、シリコンウェーハ再生事業（1984年1月よりラサ工業で事業展開）を主たる事業として株式会社 RS Technologiesを設立
2011年（平成23年）1月	三本木工場において操業開始（ラサ工業株式会社を退職した従業員の一部を雇用）
2011年（平成23年）11月	三本木工場がUKASより「ISO9001:2008」（品質マネジメントシステム）認証取得
2013年（平成25年）3月	機械販売事業開始
2013年（平成25年）10月	三本木工場においてソーラー事業を開始
2014年（平成26年）2月	台湾に子会社として艾爾斯半導體股份有限公司（現・連結子会社）を設立
2015年（平成27年）3月	東京証券取引所マザーズに株式を上場
2015年（平成27年）6月	最先端設備（450mmウェーハ再生可能）を導入した三本木工場・第8工場が竣工
2015年（平成27年）10月	第13回「デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジー Fast50」において成長率1299.53%を記録し3位受賞
2015年（平成27年）12月	艾爾斯半導體股份有限公司（現・連結子会社）の台南工場が竣工
2016年（平成28年）9月	東京証券取引所市場第一部（東証一部）へ市場変更
2017年（平成29年）12月	北京有色金属研究総院(GRINM)及び福建倉元投資有限公司と三社間で合併契約を締結
2018年（平成30年）1月	北京有研RS半導体科技有限公司(BGRS)を設立、中国プライムウェーハ製造メーカーである有研半導体材料有限公司(GRITEK)を連結子会社化
2018年（平成30年）5月	株式会社ユニオンエレクトロニクス株式取得（日立パワーデバイスの特約店）
2018年（平成30年）8月	山東有研半導体材料有限公司を設立
2018年（平成30年）11月	株式会社DG Technologiesの連結子会社化を決議

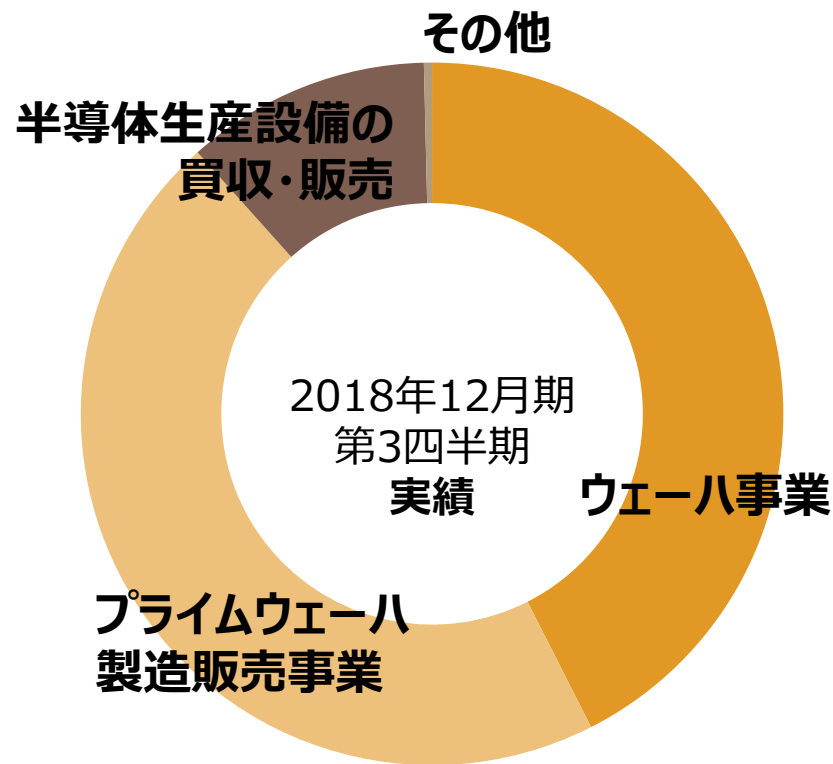
現在のRS Technologies

- 再生ウェーハ中心のウェーハ事業とプライムウェーハ製造販売事業がそれぞれ売上の4割以上を占める。そのほかアジア向け中心の半導体生産設備の買取・販売、ソーラー事業などを展開

連結売上高および営業利益率



セグメント別業績



代表取締役 方永義の強み

- 代表取締役社長である**方永義**が20年以上にわたって日本で培った知見と自身が持つネットワークを生かした全世界への販売力・人脈力・提携力・資金力が強み。
- 方永義の下にハイテクや金融など幅広い分野のプロフェッショナル人財が集結。



方永義は 前列中央（2016年9月、東京証券取引所にて撮影）

方 永義（ほう ながよし）

1970年生まれ 中国福建省出身
城西国際大学院 修了

得意分野：
M & A、業務提携（過去10社を超えるM & Aを成功）

1998年 永輝商事設立
2010年 当社設立社長就任（現任）

大切にしている心：**為せば成る**

補足：

高校卒業後に来日。日本国内外で20以上の会社の投資経験。「半導体事業」の他、ファンドや貿易、ホテル、IT事業、農業等様々な業界の投資を経験。「日本のものづくりは世界一」との信条の元、それを世界に広めていくため、世界中を飛び回っている。

2018年12月期第3四半期決算概要

2018年12月期第3四半期累計決算概要

- ウェーハ事業が引き続き好調に推移するとともに、北京工場（プライムウェーハ製造販売事業）の稼働が堅調に推移していることが収益に寄与。
- 2018年に連結子会社化した2社の連結処理でそれぞれ「負ののれん」を特別利益として計上。
 - 北京有研RS半導体材料有限公司 約34百万円の「負ののれん」
 - ユニオンエレクトロニクス 約64百万円の「負ののれん」

(百万円)	2017年12月期 第3四半期累計	2018年12月期 第3四半期累計	前期比	通期 進捗率	2018年12月期 通期予算*
売上高	7,874	18,623	+136.5%	73.0%	25,520
営業利益	2,069	3,972	+91.9%	72.2%	5,500
営業利益率	26.3%	21.3%			21.6%
経常利益	2,251	4,286	+90.4%	73.8%	5,810
経常利益率	28.6%	23.0%			22.8%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,501	2,383	+58.7%	76.6%	3,110
一株当たり当期 純利益	135.62円	196.28円	+60.66円		256.10円

*2018年11月13日開催の取締役会にて決議した通期業績予想を表示しております。

2018年12月期第3四半期決算概要

- プライムウェーハ事業及び半導体生産設備の買取・販売事業が好調であったことや円安による為替評価益等が増益に寄与。
- 2018年に連結子会社化した北京有研RS半導体材料有限公司に追加出資を実施し、「負ののれん」約11百万円を特別利益として計上。

(百万円)	2017年12月期 第3四半期	2018年12月期 第3四半期	前年同期比	差額
売上高	2,903	7,079	+143.9%	+4,176
営業利益	665	1,710	+157.1%	+1,045
営業利益率	22.9%	24.2%		
経常利益	653	1,862	+185.1%	+1,209
経常利益率	22.5%	26.3%		
親会社株主に帰属する 当期純利益	432	1,014	+134.7%	+582
一株当たり当期純利益	38.74円	80.54円	+41.80円	

2018年12月期第3四半期累計決算概要 セグメント及び会社別動向

- ウェーハ事業が引き続き好調に推移するとともに、北京工場（プライムウェーハ製造販売事業）の稼働が堅調に推移していることが収益に寄与。

セグメント別 (百万円)	ウェーハ事業		プライムウェーハ製造 販売事業		半導体生産設備 の買取・販売		その他		連結合計	
		前期比		前期比		前期比		前期比		前期比
売上高	8,035	+20.1%	8,662	—	2,128	+90.0%	△202	—	18,623	+136.5%
営業利益	2,875	+25.9%	1,398	—	169	+10.1%	△470	—	3,972	+91.9%
営業利益率	35.8%	+1.7pt	16.1%	—	7.9%	△5.8pt	—	—	21.3%	△5.0pt

会社別* (百万円)	RS		台湾子会社		北京子会社		連結消去		連結合計	
		前期比		前期比		前期比		前期比		前期比
売上高	7,730	+26.7%	2,203	+17.2%	8,662	—	△533	—	18,623	+136.5%
営業利益	1,784	+26.3%	741	+22.9%	1,398	—	44	—	3,972	+91.9%
営業利益率	23.1%	△0.1pt	33.6%	+1.5pt	16.1%	—	—	—	21.3%	△5.0pt

*子会社ユニオンエレクトロニクスは2018年第2四半期から連結対象であり、その影響が軽微であることから、会社別動向から省略しています。

- 中国でのプライムウェーハメーカーの子会社化とそのための資金調達のための新株発行により、資産及び負債・純資産合計が大幅に拡大。

連結貸借対照表		
(百万円)	2017年12月期	2018年12月期 第3四半期
資産の部		
流動資産	7,625	25,758
現金及び預金	3,243	14,475
受取手形及び売掛金	3,141	7,254
商品及び製品	463	1,136
固定資産	4,843	10,145
有形固定資産	4,674	8,691
無形固定資産	19	1,104
投資その他資産	149	350
資産合計	12,468	35,903
負債の部		
流動負債	3,384	6,095
支払手形及び買掛金	398	1,780
有利子負債	1,266	1,765
固定負債	3,291	3,405
長期借入金	2,767	2,610
負債合計	6,676	9,500
純資産の部		
純資産	5,792	26,402
負債・純資産合計	12,468	35,903

期末配当政策

- 期末配当予想については、足元の業況が概ね堅調に推移していること等を勘案し、前期実績の1株当たり5.0円から5.0円増配し、1株当たり10.0円に修正。
- 株主優待制度については、従前の内容（100株以上保有の株主様に一律クオカード3,000円分贈呈）を継続予定。

	2018年12月期 第2四半期	2018年12月期 期末予想	年間
配 当 金	0.0円	10.0円	10.0円
株 主 優 待	—	クオカード 3,000円	クオカード 3,000円

(ご参考)	2017年12月期 第2四半期	2017年12月期 期末	年間
配 当 金	0.0円	5.0円	5.0円
株 主 優 待	—	クオカード 3,000円	クオカード 3,000円

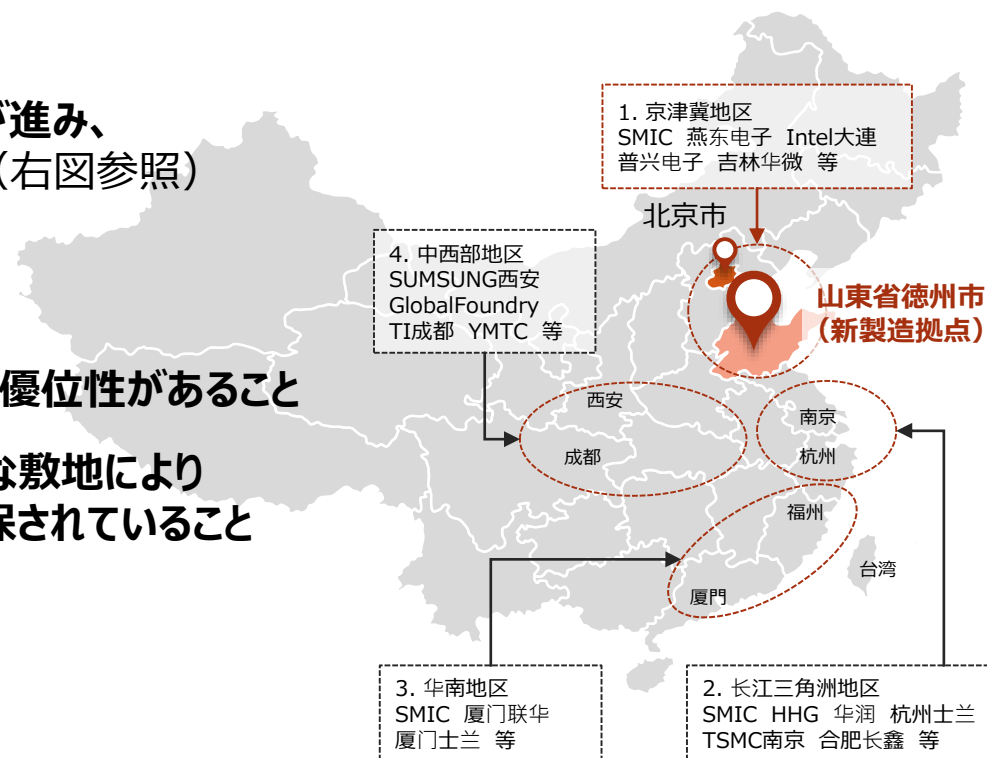
中国プライムウェーハ事業の現状

山東省徳州市と提携 子会社を設立し、工場建設へ

- 当社の連結子会社であるGRITEKと山東省徳州市で提携。
- 2018/8/23に新会社（山東有研半導体材料有限公司）設立。

提携の背景

1. 周辺に世界的な主要半導体メーカーの工場誘致が進み、半導体メーカーの集積地に近い好立地であること（右図参照）
2. 水道光熱費の低減や安価な社宅の提供といった福利厚生面が充実していること
3. 理工系大学が近隣にあり、優秀な人材獲得の面で優位性があること
4. 最大約50万 m^2 （当初は20万 m^2 ）まで拡張可能な敷地により今後の中国事業推進に十分対応できる用地が確保されていること



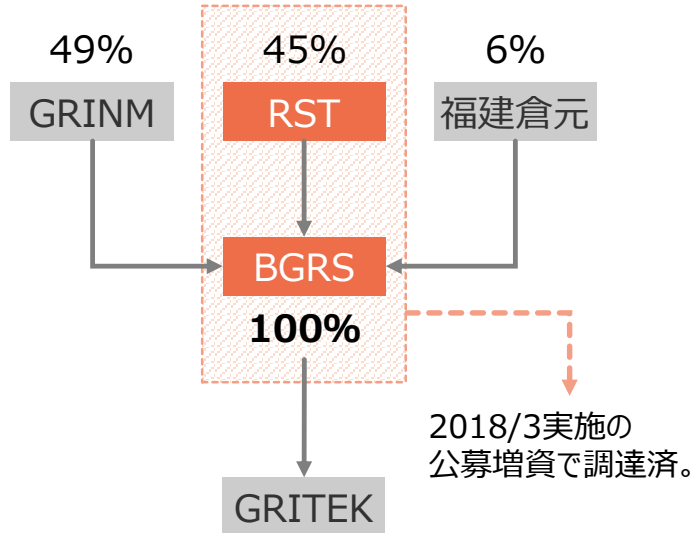
出資スキーム

- GRITEKは2017年までGRINMの100%子会社。
- 当社がプライムウェーハ事業に参入企図し、現地の会社をグループ化する必要があったため、2018年よりRSと福建倉元が現金出資・GRINMが現物出資し、BGRSを設立。BGRSがGRITEKを子会社化。
- 設備投資のリスクを軽減するために、徳州政府と提携。新会社を設立済。

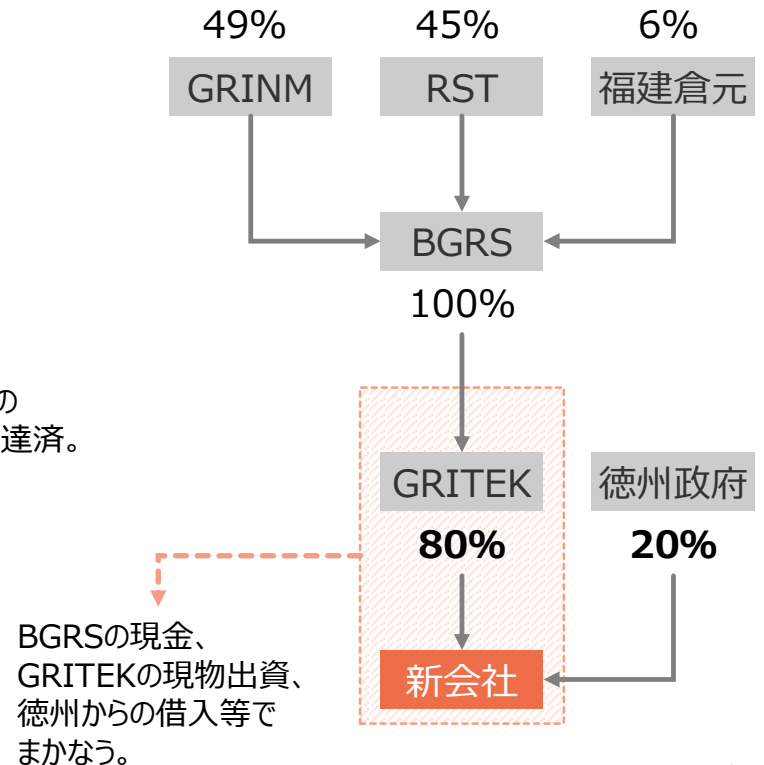
2017/12までの出資形態



2018/1からの出資形態

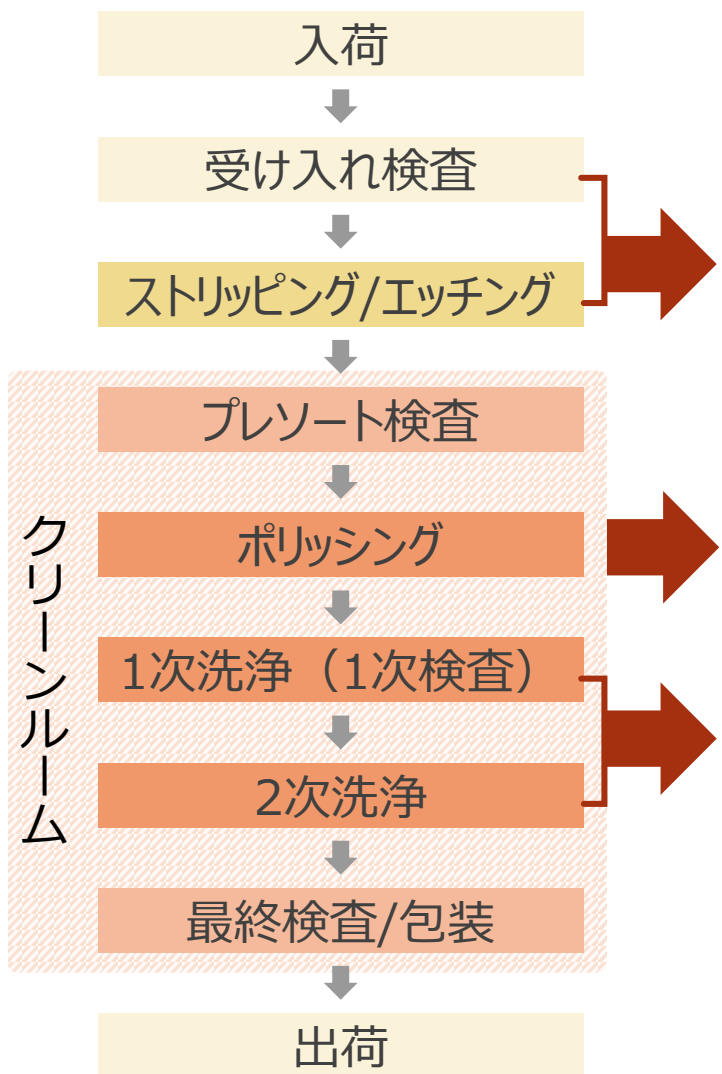


今後の出資形態



*出資比率は最終的な出資比率であり、出資契約に基づき実施いたします。

Appendix



強み1

すべての膜を剥離可能

- ケミカルによる除去の為、表面のダメージが最小限に

▶ 再生回数が多い ▶ よりコストダウンが可能

ラサ工業（化学）の特異技術を継承



表面に付いているキズや凹凸を研磨（ポリッシング）により平滑にする

強み2

金属不純物を除去

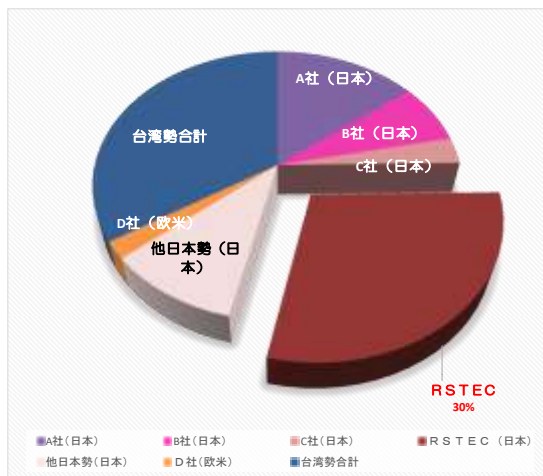
- ウェーハ表面の微細ゴミ・汚れを洗浄で取り除く
- + 金属不純物を除去 特に銅 (Cu) の除染除去に強み



再生ウェーハビジネス(2)

再生市場での当社のシェア拡大

300mm再生市場における当社シェア



台湾の新設・三本木の増設により、生産能力が増加、現在のシェアは30%に上昇

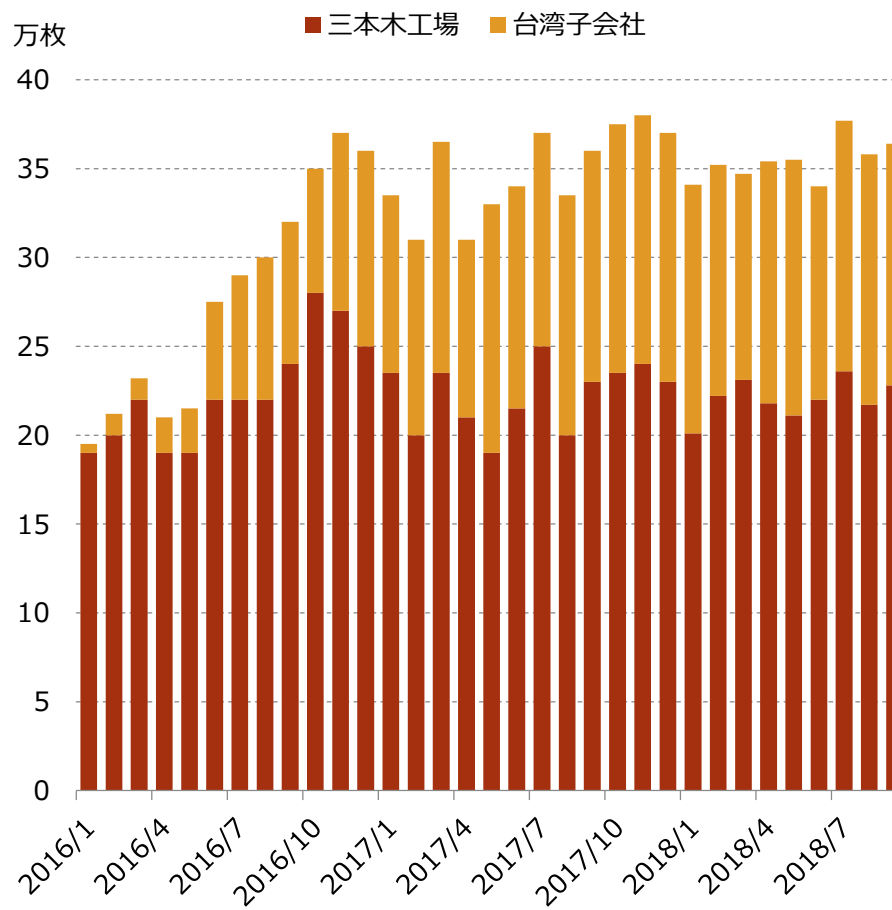
両工場の既存設備によるさらなる生産力のアップ、三本木の空工場利用、業務提携・M&A等の手法を用いて

**2018年に40%
にシェアを拡大**

	2015年 上期	2015年 下期	2016年	2017年	2018年 目標
当社グループ 生産能力	18万枚	24万枚	28万枚	30万枚	≥40% 目標
当社グループ シェア	19%	24%	29%	30%	

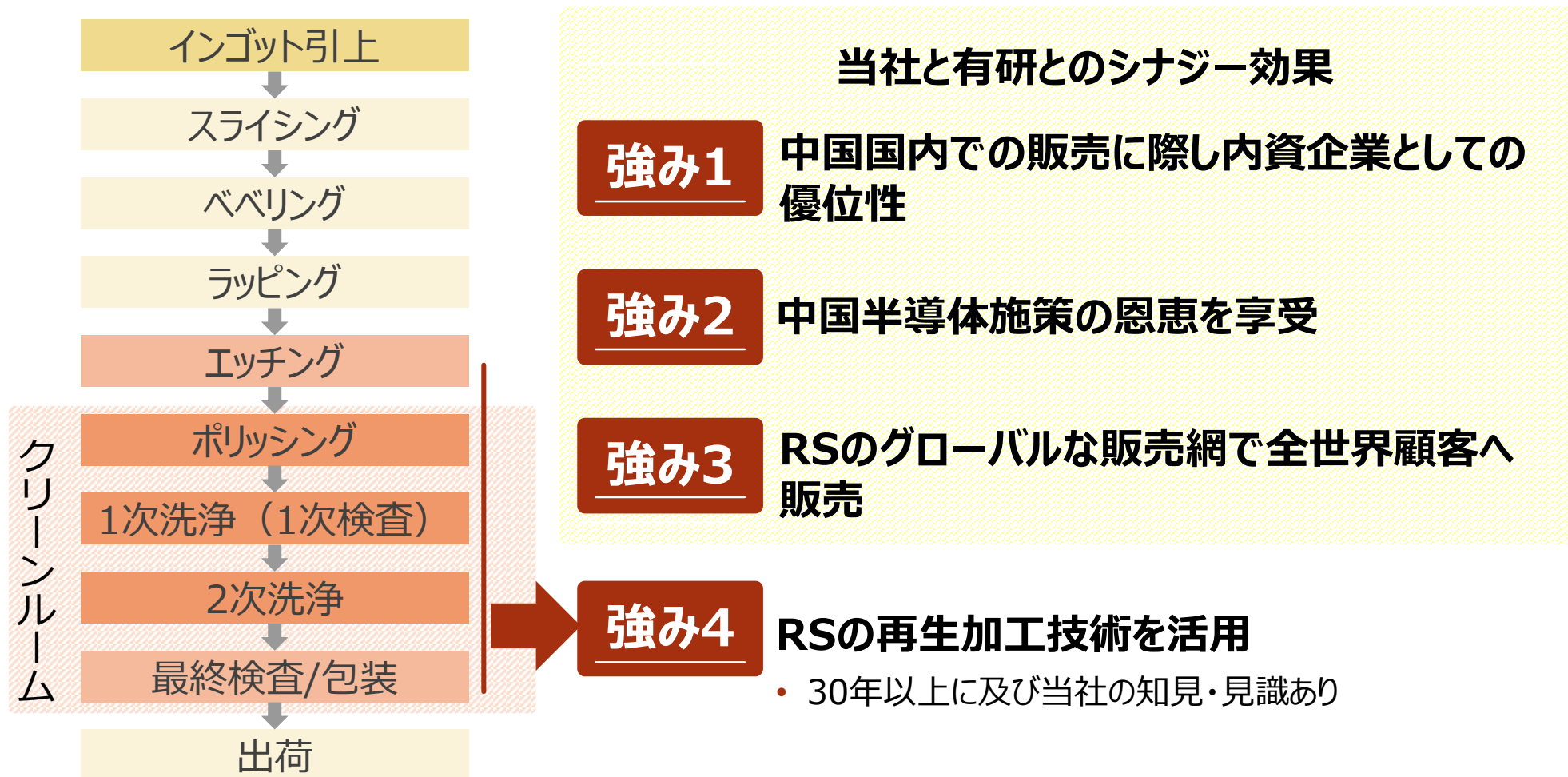
三本木工場と台湾子会社の出荷推移 (2016年-2018年)

三本木工場と台湾子会社の300mmウェーハ出荷枚数推移



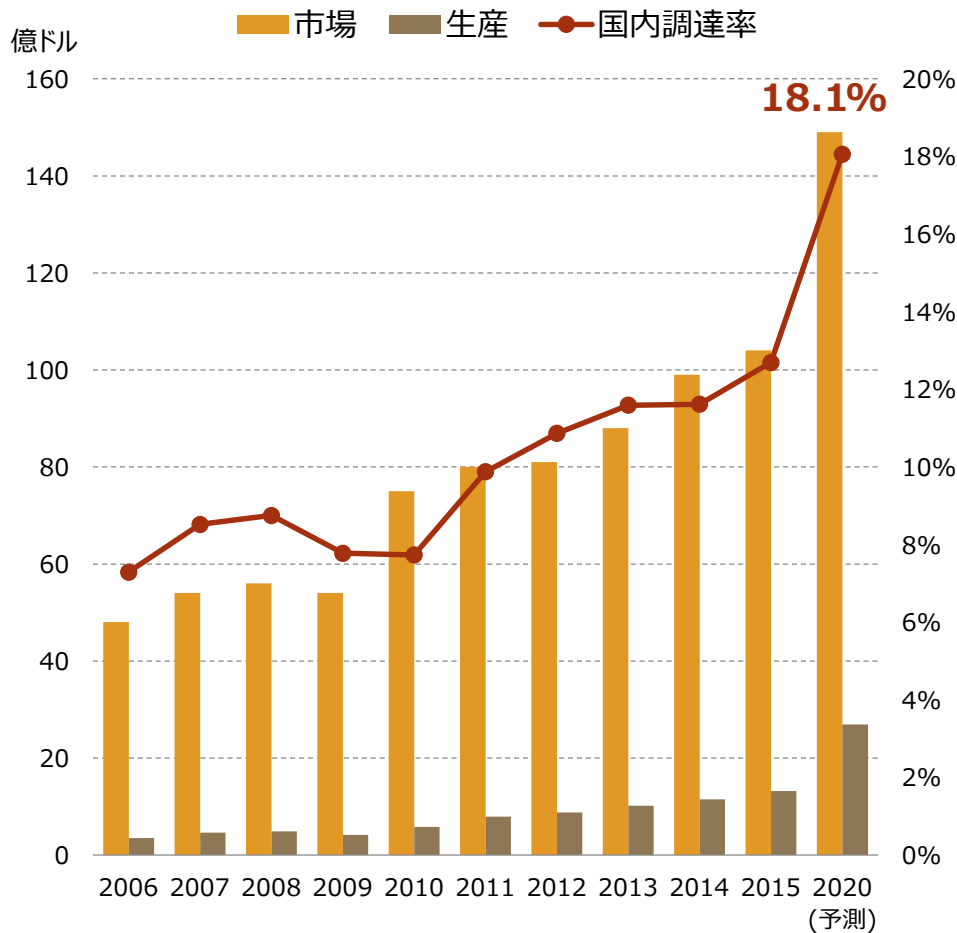
プライムウェーハビジネスに進出

- 中国中央政府直属企業の北京有色金属研究総院（現 有研科技集团有限公司）との合併会社を設立。内資企業（中国の国内企業）として半導体事業を推進



中国の半導体政策：国産化率のアップを目指す

中国における半導体市場および生産動向



中国の半導体消費は世界の4割を占めるまで成長
一方、国産化率はその内10%程度



国産化率の引き上げが**重要な政策課題**に

2014年6月

「**国家集成电路産業発展推進綱要**」

(国家IC産業発展推進ガイドライン)

2015年5月

「**中国製造2025**」

<以下引用> (メイド・イン・チャイナ2025)

China is aiming to improve the self-sufficiency rate for ICs in the nation to **40% in 2020**, and boost the rate further to **70% in 2025**.

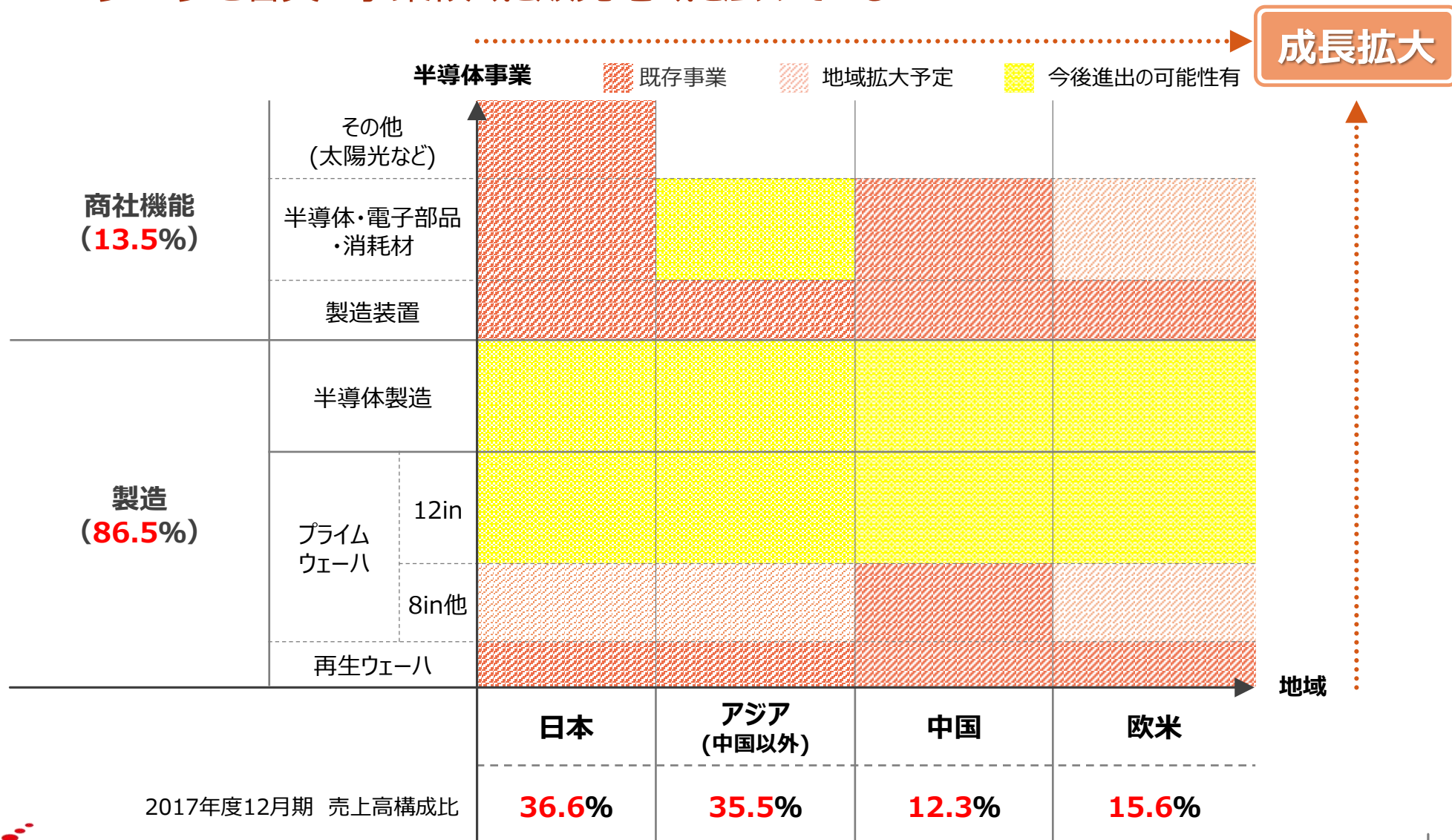


目標は、
2020年に国産化率**40%**、2025年に**70%**

出所：SEMI通信 2017年8月号 Report 1

RS Technologiesの目指す世界

■ 一步一步と着実に事業領域と販売地域を広げている



当該資料に記載された内容は、一般的に認識されている経済情勢及び当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営を取りまく様々な環境の変化により、予告なしに変更される可能性がございます。

本発表において提供される資料ならびに情報の中には「見通し情報」が含まれております。これらの情報は、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実際には異なる結果となる不確実性を含んでおります。

今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。